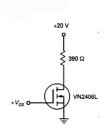
Grupo 4. Tarea:11



¿Cuál es el VDS del MOSFET de la figura si VGS =

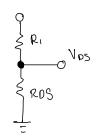
Datos: VGS (on) = 2.5 V

ID (on) = 100 mA

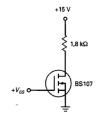
RDS(on) = 10Ω

Calculando 10 (sat)

ID(on) > ID(sAt) => 100 mA > 51.28 mA por lo que se encuentra sobresaturado



$$ROS$$
 = $VDS = \frac{10}{10 + 390 \text{ A}}$ $ZO = 0.5 \text{ IVI}$



2 Calcule la tensión en el drenador de la figura para una tensión de puerta de +3 V.

Datos: VGS (on) = 2.6 V

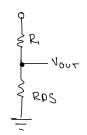
ID (on) = 20 mA

RDS(on) = 28Ω

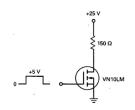
Calculando ID(SAT)

$$10 = \frac{15111}{18000} = 8.33 \text{ m} \text{ A}$$

D(on) > 1D(sA+) => 20 mA > 8.33 mA por lo que se encuentra sobresaturado Se resuelle pour divisor de voltaje.



$$V_{out} = V_{pS} = \frac{78 \text{ r}}{1808 + 78 \text{ r}} = 60.2798 \text{ IV}$$



3 Si VGS es alto en la figura ¿Cuál es el voltaje a través de la resistencia de carga?

Datos: VGS (on) = 5 V

ID (on) = 200 mA

RDS(on) = 7.5Ω

Calculando (pcsat)

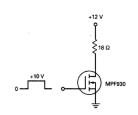
=> 2006 mA > 166.66 mA por lo que se encuentra sobresaturado D(on) > ID(srt)



Corriente en RL

Por ley de ohm

$$V_{L} = 1.R_{L} = (158.73 \times 10^{-3})(150)$$
 $V_{L} = 73.80951VI$



4 Calcule la tensión a través del MOSFET de la figura para una tensión de entrada alta.

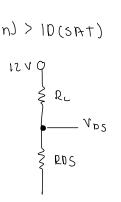
Datos: VGS (on) = 10 V

ID(on) = 1

RDS(on) = 0.9Ω

Calculando 10(SAT)

ID(On) > ID(SAT) => 1 A > 0.66 A por lo que se encuentia sobresaturado



$$V_{05} = V_{mosfet} = \frac{0.9}{18.9}$$
 12 = 0.5714111